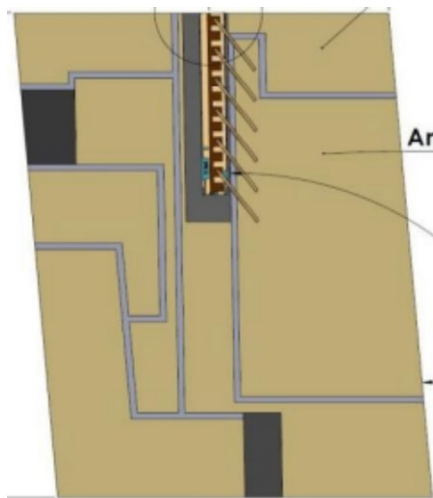




1320nm高温高功率DFB激光芯片



产品描述:

1320nm高温高功率DFB激光芯片适合在高温下工作, 具有超低的RIN 噪声和高输出光功率等优点。输出功率高达250mW。可根据客户的需求提供波长定制服务。

产品特点:

- 高功率和高温的设计
- 在大的温度和电流范围内无跳模
- 低光束发射角
- 高边模抑制比 (SMSR)
- 低RIN
- 高反馈可持续性

产品应用:

- 光信号收发器
- 数据中心





技术参数:

推荐的操作条件				
参数	最小值	典型值	最大值	单位
芯片温度	65	85	105	°C
正向电流		800	900	mA
输出功率	20		250	mW

基本参数对每个样品进行测试@ CW, 85C, 800mA)				
参数	最小值	典型值	最大值	单位
输出功率@ 900mA	250			mW
正向电压		1.5	3	V
阈值电流		100	130	mA
功率转换效率		18		%
峰值波长*	1315	1320	1325	nm
波长温度调谐系数		90		pm/°C
波长电流调谐系数		2.9		pm/mA
边模抑制比 (SMSR)	40	45		dB
慢轴光束发散角 (FWHM)	7	8	9	deg
快轴光束发散角 (FWHM)	33	35	37	deg
偏振消光比 (PER)	15	20		dB
偏振		TE		

* 可根据要求提供范围1270-1330nm范围的其他波长

噪声特性 (条件 @ CW, 85C, 800mA)				
参数	最小值	典型值	最大值	单位
线宽 (自外差法 @ 80MHz)		1	5	MHz
相对强度噪声 (RIN)*			-140	dB/Hz
反馈灵敏度 (optical)**			-30	dB

* 平均值, 测量范围为DC-10GHz

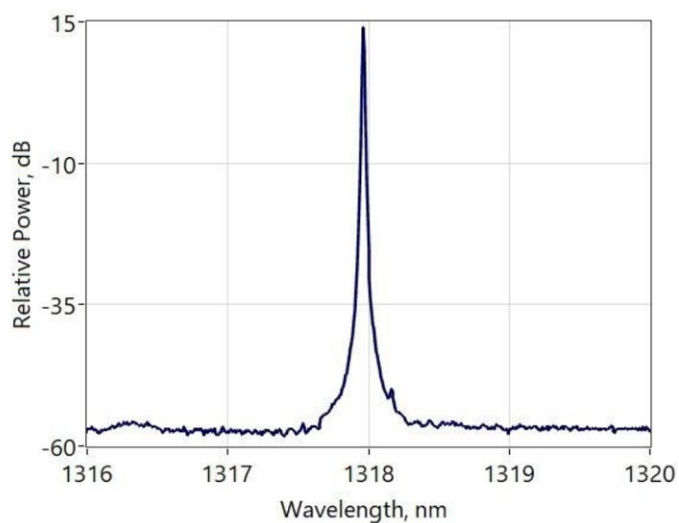
** 单线光谱和RIN<-140dB/Hz

芯片参数				
参数	最小值	典型值	最大值	单位
芯片长度		3		mm
前端面的背向反射		0.01	0.1	%
后端面的背向反射	90	99		%

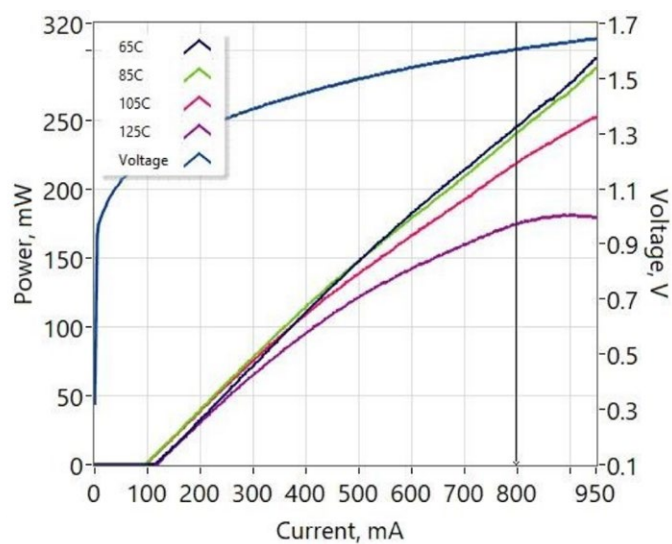




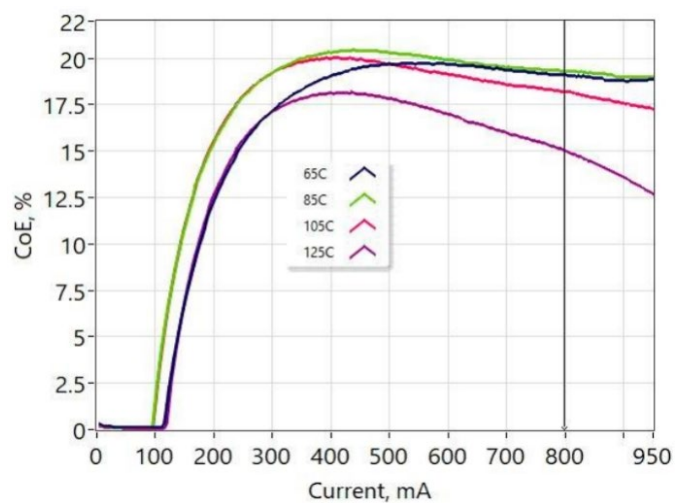
光谱图:



光电流-电压-功率特性:

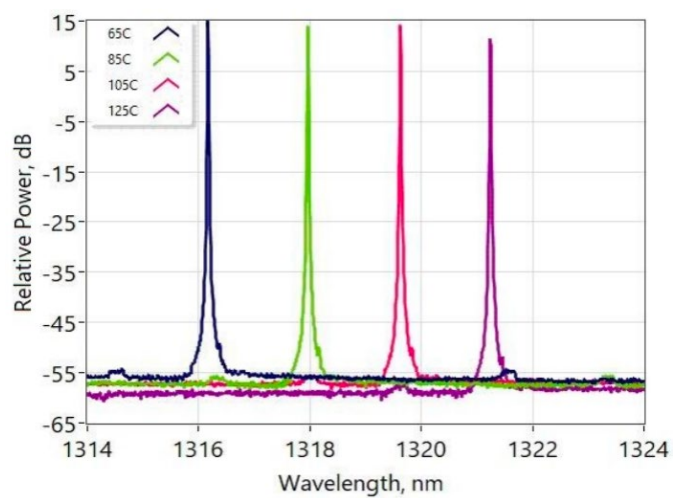


功率转换效率:

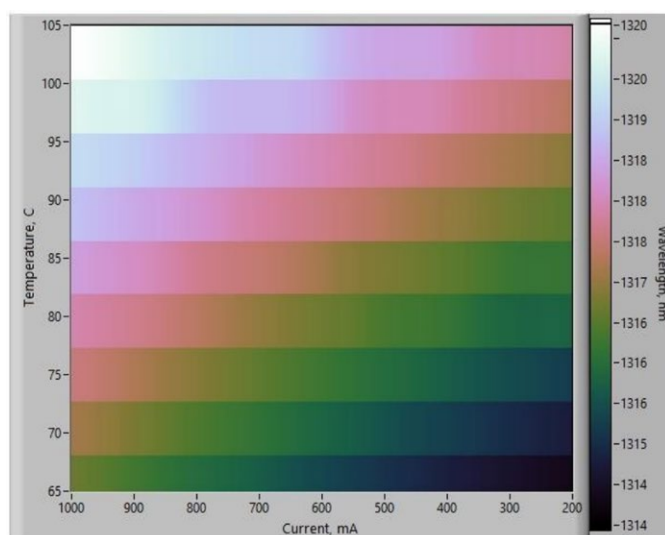




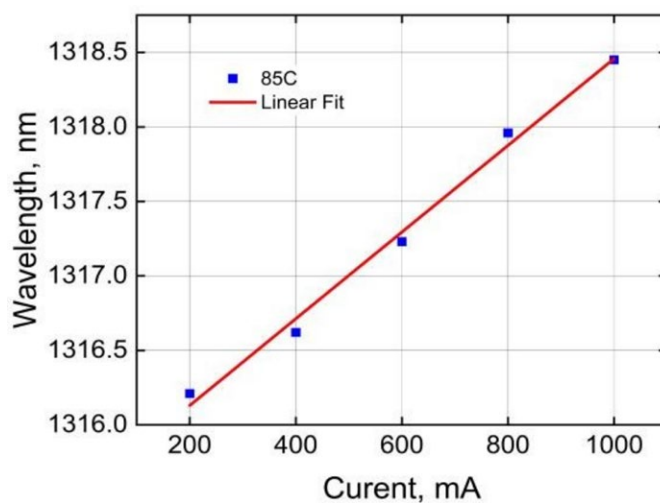
光谱 (res. 10pm):



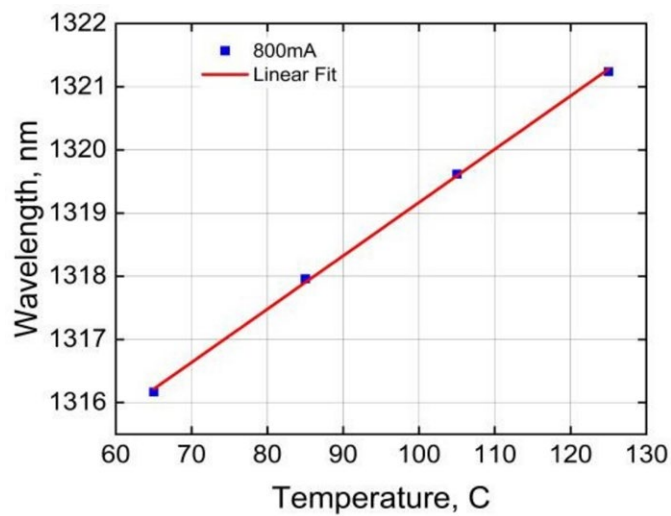
峰值波长图:



波长电流调谐曲线:



波长温度调谐曲线:



绝对最大值参数:

参数	Min	Max	Unit
正向电流		950	mA
反向电压		1	V
工作温度	5	125	°C
焊接温度 (5 sec max)		250	°C
存储温度 (采用原始密封包装)	-40	85	°C

尺寸信息:

